

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4269056号
(P4269056)

(45) 発行日 平成21年5月27日(2009.5.27)

(24) 登録日 平成21年3月6日(2009.3.6)

(51) Int. Cl. F I
G O 2 B 5/18 (2006.01) G O 2 B 5/18
G O 2 B 6/02 (2006.01) G O 2 B 6/10 C

請求項の数 14 (全 15 頁)

<p>(21) 出願番号 特願2004-259563 (P2004-259563) (22) 出願日 平成16年9月7日(2004.9.7) (65) 公開番号 特開2006-78546 (P2006-78546A) (43) 公開日 平成18年3月23日(2006.3.23) 審査請求日 平成19年8月22日(2007.8.22)</p> <p>特許法第30条第1項適用 2004年3月8日 社団法人電子情報通信学会発行の「E i C電子情報通信学会2004年総合大会講演論文集」に発表</p>	<p>(73) 特許権者 304023994 国立大学法人山梨大学 山梨県甲府市武田四丁目4番37号 (74) 代理人 100083116 弁理士 松浦 憲三 (72) 発明者 埴 雅典 山梨県甲府市武田4丁目3-11 国立大学法人山梨大学内 審査官 井口 猶二</p>
---	--

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高密度光くし型フィルタ及びその作製方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

実質的に同一の反射帯域を有するサブグレーティングを離散的かつ等間隔に配置したくし型反射特性を有する複数の超格子構造グレーティングが一次元光導波路に形成され、

前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングが他の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの間に形成されると共に、前記各超格子構造グレーティングのくし型反射特性の反射ピークの波長が他の超格子構造グレーティングのくし型反射特性の反射ピークの波長の間となるように前記各超格子構造グレーティングが異なるくし型反射特性を有して形成されることを特徴とする高密度光くし型フィルタ作製方法。

【請求項2】

前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有する均一グレーティングピッチのグレーティングであることを特徴とする請求項1記載の高密度光くし型フィルタ作製方法。

【請求項3】

前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有するアボダイズグレーティングであることを特徴とする請求項1記載の高密度光くし型フィルタ作製方法。

【請求項4】

前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有するチャープグレーティングであることを特徴とする請求項1記載の高密度光くし型フ

フィルタ作製方法。

【請求項 5】

前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、前記くし型特性を有する光フィルタのくし型特性の反射ピークの波長間隔が実質的に一定となるような間隔で配置されていることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のうちいずれか 1 に記載の高密度光くし型フィルタ作製方法。

【請求項 6】

前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの反射特性は、全て実質的に同一であることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のうちいずれか 1 に記載の高密度光くし型フィルタ作製方法。

10

【請求項 7】

前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの反射特性は、各々異なることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のうちいずれか 1 に記載の高密度光くし型フィルタ作製方法。

【請求項 8】

実質的に同一の反射帯域を有するサブグレーティングを離散的かつ等間隔に配置したくし型反射特性を有する複数の超格子構造グレーティングが一次元光導波路に形成され、

前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングが他の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの間に形成されると共に、前記各超格子構造グレーティングのくし型反射特性の反射ピークの波長が他の超格子構造グレーティングのくし型反射特性の反射ピークの波長の間となるように前記各超格子構造グレーティングが異なるくし型反射特性を有することを特徴とする高密度光くし型フィルタ。

20

【請求項 9】

前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有する均一グレーティングピッチのグレーティングであることを特徴とする請求項 8 記載の高密度光くし型フィルタ。

【請求項 10】

前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有するアボダイズグレーティングであることを特徴とする請求項 8 記載の高密度光くし型フィルタ。

30

【請求項 11】

前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有するチャープグレーティングであることを特徴とする請求項 8 記載の高密度光くし型フィルタ。

【請求項 12】

前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、前記くし型特性を有する光フィルタのくし型特性の反射ピークの波長間隔が実質的に一定となるような間隔で配置されていることを特徴とする請求項 8 乃至 11 のうちいずれか 1 に記載の高密度光くし型フィルタ。

【請求項 13】

前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの反射特性は、全て実質的に同一であることを特徴とする請求項 8 乃至 12 のうちいずれか 1 に記載の高密度光くし型フィルタ。

40

【請求項 14】

前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの反射特性は、各々異なることを特徴とする請求項 8 乃至 12 のうちいずれか 1 に記載の高密度光くし型フィルタ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は高密度光くし型フィルタ及びその作製方法に係り、特にインタリーブにより超

50

格子構造グレーティングのくし型反射特性を高密度化する高密度光くし型フィルタ及びその作製方法に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、全光ネットワークの実現に向けて研究が行われており、様々な光信号処理技術が必要とされている。光信号処理技術の実装手段の一つとして、光ファイバなどの一次元光導波路のコア内に屈折率変化による回折格子を形成したブラッググレーティングという光デバイスが知られている。中でも光ファイバのコアに回折格子を形成したデバイスはファイバグレーティング（FBG：Fiber Bragg Grating）と呼ばれており（例えば特許文献1，2参照）、小型で安価なデバイスであり、また、光ファイバとの親和性が高いという特徴がある。尚、本発明はFBGに限定されるものではなく、平面光導波路に作製するブラッググレーティングなどにも適用が可能であるが、本明細書ではFBGを例にして説明する。

10

【0003】

また、FBGを応用したファイバグレーティング型デバイスの一つに超格子構造ファイバグレーティング（SSFBG：Super Structure Fiber Bragg Grating（別名：標本化ファイバグレーティング（Sampled (Fiber) Grating））が知られている。SSFBGは、光ファイバのコア内にFBG（サブFBG）を離散的かつ等間隔に配置したもので、くし型の反射特性を持つ光くし型フィルタとして機能する。SSFBGは、多波長の光を一括してフィルタリングできるため、多波長光源やWDM通信システム等においてシステムの低価格化や簡易化を実現するデバイスとして期待されている。

20

【0004】

更に、SSFBGのくし型特性を高密度化する技術として多点位相シフト（MPS）法が提案されている（例えば、那須悠介、山下真司：“DWDM用スーパーストラクチャーファイバブラッググレーティングの新しい作成法 - 位相マスク走査法と多点位相シフト法 - ”、電子情報通信学会技術研究報告OFT2001-43（2001-10）、又は、特許文献3等参照）。通常のSSFBGにおいてくし型特性を高密度化するためにはサブFBGの間隔を広くする必要があり、そのためにデバイス長が長く（～数十cm）なるが、長いデバイスは不便である上に、簡便にFBGを作製できる位相マスク法では位相マスク長によって全長が制限されるため現実的ではない。これに対して多点位相シフト法は、ある間隔でサブFBGが配置されたSSFBGにおいて、サブFBGの間にUV（紫外）光を照射して光路長を延ばし、かつ、適切な位相シフトを与える方法であり、サブFBGの間隔を短く保ったままくし型特性を高密度化することができる。

30

【特許文献1】特許第2521708号公報

【特許文献2】特開平06 235808号公報

【特許文献3】特開2003-4926号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、多点位相シフト法では、位相シフト量の制御が困難であるため、所望の特性のSSFBGを簡易に作製することができないという欠点があった。

40

【0006】

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、小型で高密度のくし型フィルタを簡易に作製することができる高密度光くし型フィルタ及びその作製方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

前記目的を達成するために、請求項1に記載の高密度光くし型フィルタ作製方法は、実質的に同一の反射帯域を有するサブグレーティングを離散的かつ等間隔に配置したくし型反射特性を有する複数の超格子構造グレーティングが一次元光導波路に形成され、前記各

50

超格子構造グレーティングのサブグレーティングが他の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの間に形成されると共に、前記各超格子構造グレーティングのくし型反射特性の反射ピークの波長が他の超格子構造グレーティングのくし型反射特性の反射ピークの波長の間となるように前記各超格子構造グレーティングが異なるくし型反射特性を有して形成されることを特徴としている。

【0008】

本発明によれば、インタリーブされた複数の超格子構造グレーティングによってくし型反射特性が高密度化されると共に、各超格子構造グレーティングを構成するサブグレーティングが他の超格子構造グレーティングを構成するサブグレーティングの間に形成されるため、デバイス長を短く保ったままで高密度のくし型フィルタを作製することができる。また、本発明により作製するくし型フィルタは超格子構造グレーティングを作製するための従来の方法を用いることができるため簡易に作製することができる。

10

【0009】

請求項2に記載の高密度光くし型フィルタ作製方法は、請求項1に記載の発明において、前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有する均一グレーティングピッチのグレーティングであることを特徴としている。

【0010】

請求項3に記載の高密度光くし型フィルタ作製方法は、請求項1に記載の発明において、前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有するアボダイズグレーティングであることを特徴としている。アボダイズグレーティングは一次元光導波路の長手方向に対して屈折率変化量を変化させたグレーティングである。

20

【0011】

請求項4に記載の高密度光くし型フィルタ作製方法は、請求項1に記載の発明において、前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有するチャープグレーティングであることを特徴としている。チャープグレーティングは一次元光導波路の長手方向に対して屈折率変化の周期を変化させたグレーティングである。

【0012】

請求項5に記載の高密度光くし型フィルタ作製方法は、請求項1乃至4のうちいずれか1に記載の発明において、前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、前記くし型特性を有する光フィルタのくし型特性の反射ピークの波長間隔が実質的に一定となるような間隔で配置されていることを特徴としている。

30

【0013】

請求項6に記載の高密度光くし型フィルタ作製方法は、請求項1乃至5のうちいずれか1に記載の発明において、前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの反射特性は、全て実質的に同一であることを特徴としている。

【0014】

請求項7に記載の高密度光くし型フィルタ作製方法は、請求項1乃至5のうちいずれか1に記載の発明において、前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの反射特性は、各々異なることを特徴としている。

40

【0015】

請求項8に記載の高密度光くし型フィルタは、実質的に同一の反射帯域を有するサブグレーティングを離散的かつ等間隔に配置したくし型反射特性を有する複数の超格子構造グレーティングが一次元光導波路に形成され、前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングが他の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの間に形成されると共に、前記各超格子構造グレーティングのくし型反射特性の反射ピークの波長が他の超格子構造グレーティングのくし型反射特性の反射ピークの波長の間となるように前記各超格子構造グレーティングが異なるくし型反射特性を有することを特徴としている。本発明によれば、インタリーブされた複数の超格子構造グレーティングによってくし型反射特性が高

50

密度化されると共に、各超格子構造グレーティングを構成するサブグレーティングが他の超格子構造グレーティングを構成するサブグレーティングの間に形成されるため、デバイス長を短く保ったままで高密度のくし型フィルタを実現することができる。また、本発明により作製するくし型フィルタは超格子構造グレーティングを作製するための従来の方法を用いることができるため簡易に作製することができる。

【0016】

請求項9に記載の高密度光くし型フィルタは、請求項8に記載の発明において、前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有する均一グレーティングピッチのグレーティングであることを特徴としている。

【0017】

請求項10に記載の高密度光くし型フィルタは、請求項8に記載の発明において、前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有するアポダイズグレーティングであることを特徴としている。

【0018】

請求項11に記載の高密度光くし型フィルタは、請求項8に記載の発明において、前記各超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、実質的に同一の反射帯域を有するチャープグレーティングであることを特徴としている。

【0019】

請求項12に記載の高密度光くし型フィルタは、請求項8乃至11のうちいずれか1に記載の発明において、前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングは、前記くし型特性を有する光フィルタのくし型特性の反射ピークの波長間隔が実質的に一定となるような間隔で配置されていることを特徴としている。

【0020】

請求項13に記載の高密度光くし型フィルタは、請求項8乃至12のうちいずれか1に記載の発明において、前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの反射特性は、全て実質的に同一であることを特徴としている。

【0021】

請求項14に記載の高密度光くし型フィルタは、請求項8乃至12のうちいずれか1に記載の発明において、前記複数の超格子構造グレーティングのサブグレーティングの反射特性は、各々異なることを特徴としている。

【発明の効果】

【0022】

本発明に係る高密度光くし型フィルタ及びその作製方法によれば、小型で高密度のくし型フィルタを簡易に作製することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0023】

以下、添付図面に従って本発明に係る高密度光くし型フィルタ及びその作製方法の実施の形態について詳説する。本実施の形態では本発明に係る高密度光くし型フィルタの一例としてインタリーブ超格子構造ファイバグレーティングについて説明する。

【0024】

1. 基礎原理

まず、本実施の形態で説明するインタリーブ超格子構造ファイバグレーティングの基礎原理について説明する。

【0025】

1.1 ファイバグレーティング

1.1.1 ファイバグレーティングの原理

ファイバグレーティング (FBG: Fiber Bragg Grating) とは感光性光ファイバにUV (紫外) 光を当てることによって起こる屈折率変化を利用して感光性光ファイバのコア内に周期的な屈折率変化を作り、ブラッグ回折格子を形成したファイバ型の光デバイスである。このFBGの構造を図1に示すと、同図に示すようにFBG10は、感光性ファイ

10

20

30

40

50

バ 1 2 のコア 1 4 に、ファイバ軸方向に向かって周期 f_{bg} で屈折率が周期的に変化する屈折率変化を有した構造となっている。この F B G は図 2 に示すようにファイバのコア 1 4 に入射した入射光のうち、次式 (1) に示すブラッグ条件に従うブラッグ波長を回折 (反射) し、それ以外の波長を透過する特徴がある。

【 0 0 2 6 】

$$\lambda_{bragg} = 2 \cdot n_{eff} \cdot f_{bg} \quad \dots (1)$$

ここで、 λ_{bragg} はブラッグ回折格子によって回折されるブラッグ波長、 n_{eff} はコア内の有効屈折率、 f_{bg} は屈折率変化の周期を示している。以後、屈折率変化の周期 f_{bg} をグレーティングピッチと呼ぶことにする。

【 0 0 2 7 】

図 3 は、縦軸に屈折率 n 、横軸にファイバ軸方向の位置 z をとり、ファイバ軸方向に対する屈折率変化を示した図である。ファイバのコア内に周期的な屈折率変化が作られたときに、有効屈折率 n_{eff} はファイバのコア内での屈折率の平均値を示し、屈折率変調度 Δn_{eff} は有効屈折率 n_{eff} からの屈折率の変化量を表す。

【 0 0 2 8 】

図 4 (a) は、縦軸に屈折率変調度 Δn_{eff} 、横軸にファイバ軸方向の位置 z をとり、コア内での屈折率の変化を表している。この屈折率の変化の包絡線は屈折率プロファイルと呼ばれており、一般的に屈折率プロファイルと F B G の反射特性はフーリエ変換の関係になる。図 4 (a) の例では屈折率プロファイルが矩形なので F B G の反射特性は sinc 型になる。その F B G の sinc 型の反射特性をデシベル表記で表した図 4 (b) が示すように、F B G はブラッグ波長 λ_{bragg} 近傍の光を反射する光フィルタとして利用でき、屈折率プロファイルの制御によって様々な特性の光フィルタを実現することが可能である。

【 0 0 2 9 】

1 . 2 ファイバグレーティングの作製方法

1 . 2 . 1 位相マスク法

F B G を作製する方法は色々あるが、その中で一般的に用いられている位相マスク法を本実施の形態で説明する。位相マスク法は、図 5 に示すような位相マスク 2 4 が使用される。位相マスク 2 4 は、平らで高品質な石英ガラスのプレート 2 0 の表面上に浮き彫り構造の回折格子 2 2 を形成したものである。この位相マスク 2 4 に、ある波長の U V 光を入射すると入射された U V 光は回折し、回折光がファイバのコア内で干渉する。例えば、本実施の形態における位相マスク法による超格子構造ファイバグレーティングの作製では、全長 3 c m、浮き彫り構造 (回折格子) のピッチ 1 0 7 1 n m の位相マスクが使用され、その位相マスクに波長 2 4 8 n m の U V 光が入射される。その場合に、0 次回折光が 5 % 以下、 ± 1 次回折光がそれぞれ約 3 5 %、 ± 1 次回折角が約 1 3 . 4 ° となる。従って、ファイバのコア内で起こる干渉はほとんど ± 1 次回折光によって生じる。以後、浮き彫り構造のピッチを p_{sk} とし、マスクピッチと呼ぶ。

【 0 0 3 0 】

位相マスク法の原理を図 6 を用いて説明する。同図 (a) に示すように感光性光ファイバ 1 2 を位相マスク 2 4 の直後 (下面) に密着させて配置し、上から U V 光を照射する。照射された U V 光は位相マスク 2 4 を通過する際に回折を起こし、+ 1 次回折光と - 1 次回折光が感光性光ファイバ 1 2 のコア 1 4 内で干渉し、干渉縞を形成する。このとき干渉縞は位相マスク 2 4 のピッチの半分の周期で形成される。同図 (b) に示すように干渉が強い部分では屈折率変調度 Δn_{eff} が大きくなり、干渉が弱い部分では屈折率変調度 Δn_{eff} が小さくなるため、干渉縞と同じ周期で感光性光ファイバ 1 2 のコア 1 4 内にグレーティングが作られる。

【 0 0 3 1 】

1 . 2 . 2 チルト法

F B G のブラッグ波長を変える方法について説明する。位相マスク法はマスクピッチ

10

20

30

40

50

λ_{mask} で F B G のグレーティングピッチ Λ_{fbg} が決まる。そこでブラッグ波長の異なる F B G を作るためには目的のブラッグ波長に合わせたマスクピッチの位相マスクを使うことが必要となる。本実施の形態におけるインタリーブ超格子構造ファイバグレーティングの作製では、後述のようにブラッグ波長の異なる 2 種類の F B G を作製する必要があり、各ブラッグ波長に合わせた 2 つの位相マスクが必要となる。しかし位相マスクは高価であるため、1 つの位相マスクでブラッグ波長を変化させることができるチルト法を用いる。

【 0 0 3 2 】

一般的にチルト法によってファイバのコア内に形成される F B G (チルトグレーティング) は図 7 のように位相マスク 2 4 に対して感光性ファイバ 1 2 に傾きを与えることで作製される。位相マスク 2 4 に対して感光性ファイバ 1 2 を角度 θ だけ傾けて作製した F B G の回折格子は同図に示すようにファイバ軸に対して斜めに作られるため、ファイバ軸から見るとグレーティングピッチが $\Lambda_{fbg} / \cos \theta$ になる。このためブラッグ波長は次式 (2)、

$$\lambda_{tilt} = 2 \cdot n_{eff} \cdot (\Lambda / 2) \cdot \sin \theta / \cos \theta = \lambda_{bragg} / \cos \theta \quad \dots (2)$$

となり、長波長側に変化することがわかる。

【 0 0 3 3 】

1 . 3 超格子構造ファイバグレーティング

超格子構造ファイバグレーティング (S S F B G : Superstructure fiber Bragg grating) は感光性ファイバのコア内に F B G を離散的かつ等間隔に配置したデバイスである。S S F B G の構造を図 8 に示す。同図に示すようにファイバのコア 1 4 に F B G 3 0、3 0、3 0、... が等間隔に配置されており、F B G 3 0、3 0、3 0 と、F B G が形成されていない空隙部 3 1、3 1、3 1、... とが交互に配置されている。ここで個々の F B G をサブグレーティング (サブ F B G) と呼ぶ。また、各サブ F B G 3 0、3 0、3 0、... の上部に示す λ_1 は、各サブ F B G 3 0 単体でのブラッグ波長を示し、全てのサブ F B G 3 0 のブラッグ波長が同一であることを示している。また、本実施の形態のインタリーブ超格子構造ファイバグレーティングでは同一のコア内に 2 つの S S F B G が形成されるが、そのうちの 1 つは、例えば、同図に示すようにサブ F B G 3 0 のグレーティング長 (サブ F B G 長) が 0 . 4 mm、サブ F B G の間隔 (サブ F B G 間隔) が 2 mm となっている。

【 0 0 3 4 】

図 9 (a)、(b) に示すように、S S F B G の反射特性はフーリエ変換の関係からくし型の反射特性を持つ。S S F B G はサブ F B G 長を長くすると反射特性の波長帯域幅が狭くなり、サブ F B G 間隔を長くすると反射ピークの密度が狭くなり、サブ F B G 数を増やすと反射特性の個々の反射ピークが細くかつ反射率が高くなる特徴がある。

【 0 0 3 5 】

一般的に S S F B G の反射ピークを高密度化するにはサブ F B G 間隔を長くすればよい。例として密度を 2 倍、3 倍にした時の S S F B G の構造と反射特性を図 1 0 (a)、(b)、(c) に示す。同図 (a) のサブ F B G 間隔 (2 mm) を基準として、同図 (b) はサブ F B G 間隔が 2 倍 (4 mm) の場合、同図 (c) はサブ F B G 間隔 (6 mm) が 3 倍の場合を示している。これによればピーク密度がサブ F B G 間隔に反比例していることがわかる。

【 0 0 3 6 】

このように反射ピークの密度を 2 倍、3 倍と高密度化するには、サブ F B G 間隔をそれぞれ 2 倍、3 倍に長くする必要がある。この方法を用いて反射ピークの高密度化を行うと、高密度化するにつれて全長が長くなる。例えば、1 0 GHz 間隔のピークを持つ高密度くし型フィルタを作る場合、サブ F B G 間隔を約 1 cm にしなければならず、十分な反射率を持つフィルタを作るためにサブ F B G 数を 1 5 個とすると全長が約 1 5 cm にもなる。この 1 5 cm という長さはデバイスとして大きくて扱いにくく、また、位相マスク法を利用して S S F B G を作製する場合には位相マスクの長さによって長さが制限されてしまうために、製造が難しく現実的ではない。

【 0 0 3 7 】

2. インタリーブ超格子構造ファイバグレーティング

2.1 インタリーブ法を用いた超格子構造ファイバグレーティング

本実施の形態のインタリーブ超格子構造ファイバグレーティング (ISSFBG: Interleaved superstructure fiber Bragg grating) は、小型で高密度の光くし型フィルタを作製する方法としてインタリーブ法を用いて作製される。

【0038】

2.1.1 インタリーブ法

図11(a)は通常のSSFBGの構造を示しており、同図に示すようにファイバのコア14に等間隔で生成されるブラッグ波長 λ_1 のサブFBG30、30、30、...の間(空隙部31、31、31、...)は使われていない。そこで、インタリーブ法とは、この使われていない部分にもFBGを作製して利用する方法である。図11(b)は、インタリーブ法によって作製された本実施の形態のインタリーブ超格子構造ファイバグレーティング(ISSFBG)40の構造を示している。同図に示すようにファイバのコア14に図11(a)のSSFBGと同様にサブFBG30、30、30...が形成され、各サブFBGの間にそのブラッグ波長 λ_1 と異なるブラッグ波長 λ_2 のサブFBG32、32、32、...が挟み込まれて2つのSSFBGが形成される。これによって、ファイバのコア14にサブFBG30、空隙部33、サブFBG32、空隙部35、サブFBG30、...のようにサブFBG30とサブFBG32が空隙部33、35を挟んで交互に配置される。このように構成されるISSFBG40は、デバイス長をSSFBGと同様に短く保つことができ、1.2.1節で説明した位相マスク法を使用してSSFBGを作製する場合と同様にして簡便に作製することができる。従来、この方法は例えば1560nm帯と1300nm帯の信号を同時にフィルタリングする方法として提案されている。これによれば、反射波長の帯域が十分に異なると、互いの反射特性が干渉しないため互いのサブFBGを透明とみなせることを利用している。

【0039】

2.1.2 インタリーブ超格子構造ファイバグレーティング

本実施の形態のインタリーブ超格子構造ファイバグレーティング(ISSFBG)では、インタリーブ法を2つの離れた帯域で使用するのではなく、ほぼ同じ波長で利用することで、SSFBGのくし型特性を高密度化する。具体例として図11(b)に示したISSFBG40の構造において各サブFBG30のブラッグ波長 λ_1 を1552.02nmとし、それらのサブFBG30で構成されるSSFBG(第1のSSFBGという)のサブFBG長 L_{FBG1} を0.4mm、サブFBG間隔 L_1 を2mm、サブFBG数 N_{FBG1} を12個とし、一方、各サブFBG32のブラッグ波長 λ_2 を1552.22nmとし、それらのサブFBG32で構成されるSSFBG(第2のSSFBGという)のサブFBG長 L_{FBG2} を0.40005mm、サブFBG間隔 L_2 を2.000268mm、サブFBG数 N_{FBG2} を12個とするISSFBGを作製した場合について示す。図12(a)は、第1のSSFBGの反射特性を示し、図12(b)は、第2のSSFBGの反射特性を示している。このとき、図12(a)の反射特性を持つ第1のSSFBGに、中心波長が反射ピーク間隔の半分だけずれた反射ピークを持つ図12(b)の反射特性の第2のSSFBGを挟み込むと、2つの反射特性が線形加算され、図12(c)のような反射特性を持つ高密度なくし型特性が得られるようになる。

【0040】

このようにくし型特性の反射ピークを2倍に高密度するならば、図13に示すようにISSFBG40を構成する第1のSSFBG42と第2のSSFBG44として、各SSFBGのサブFBGで反射された光波の位相がずつずれたSSFBGを2個挟み込めばよい。もし、N倍に高密度化したければ位相が $2/N$ ずつずれたSSFBGをN個挟み込めばよい。尚、位相が $2/N$ ずつずれたSSFBGをN個挟み込むと、くし型特性の反射ピークの波長間隔が実質的に一定となるが、必ずしも反射ピークの波長間隔は一定でなくてもよい。

【0041】

10

20

30

40

50

ここでSSFBGの反射特性は、SSFBGを構成する各サブFBGによって反射される光波間の位相差が $2n$ (n は整数)となる波長でピークを持ち、 $(2n+1)$ (n は整数)となる波長で谷となる。ある波長での位相差の計算は次式(3)から求めることができる。

【0042】

$$P = 2 \cdot ((2L \cdot n_{eff}) \% \lambda) / \lambda \dots (3)$$

L はサブFBG間隔であり、 $((2L \cdot n_{eff}) \% \lambda)$ は往復の光路長 $(2L \cdot n_{eff})$ を波長 λ で割った剰余を表す。例えば1550nm帯を使用する場合にはサブFBG間隔が約500nm変わると位相が 2π 変化する。図12(b)に示すような位相のずれたSSFBGを得るために行う位相の制御には、十数nm程度の微小なサブFBG間隔の制御

10

【0043】

本実施の形態では、まず第1のSSFBGを図15のように作製した後、図16のようにして作製した。これにより、同一のステージの移動量 L に対し、第2のSSFBGではサブFBG間隔は $L / \cos \theta$ となり、 θ の制御によって微小な間隔の制御が可能となった。

【0044】

また、第1のSSFBGのサブFBGのブラッグ波長 λ_1 と第2のSSFBGのサブFBGのブラッグ波長 λ_2 とは同一であってもサブFBG間隔のみの調整によってくし型特性の高密度化が図れるが、上記具体例では、第2のSSFBGにおけるサブFBGのブラッグ波長 λ_2 (中心波長)も長波長側にシフトさせた場合を示している。この場合に、第2のSSFBGのサブFBGは、1.2.2節で説明したチルト法を用いることによって第1のSSFBGのサブFBGと同一の位相マスクを使用して作製することができる。但し、マスクピッチが異なる位相マスクを使用してもよい。

20

【0045】

3. ISSFBGを用いたくし型フィルタ装置

図14は、本実施の形態のISSFBGを利用して構成されるくし型フィルタ装置の一例を示した構成図である。同図において、くし型フィルタ装置50は、本実施の形態のISSFBG40と、光サーキュレータ52と、光アンプ54から構成されている。光サーキュレータ52は第1端子52A、第2端子52B、及び、第3端子52Cの3つの端子を備えており、第1端子52Aは、くし型フィルタ装置50の入力端子50Aに接続されている。同図では、くし型フィルタ装置50の入力端子50Aには例えば広い帯域幅の光を出射する光源56が接続されており、その光源56から出射された光が光サーキュレータ52の第1端子52Aに入射されるようになっている。

30

【0046】

光サーキュレータ52の第2端子52BにはISSFBG40が接続されており、光サーキュレータ52の第1端子52Aに入射した光は第2端子52Bから出射されてISSFBG40に入射する。ISSFBG40では、入射した光の波長のうち、図12(c)に示したようにISSFBG40の高密度なくし型反射特性によって選出される波長の光が反射される。そして、ISSFBG40によって反射した光は、光サーキュレータ52の第2端子52Bに入射する。

40

【0047】

光サーキュレータ52の第3端子52Cには、光アンプ54が接続されており、ISSFBG40で反射されて光サーキュレータ52の第2端子52Bに入射した光は、第3端子54Cから出射されて光アンプ54に入射する。光アンプ54に入射した光は光アンプ54によって増幅されてくし型フィルタ装置50の出力端子50Bからフィルタ出力として出力される。このように構成されたくし型フィルタ装置50によってくし型フィルタ装置50に入力された光の波長のうち、ISSFBG40のくし型反射特性によって反射される波長の光がフィルタ装置50から出力される。

【0048】

50

以上、上記実施の形態では、I S S F B Gを2つのS S F B Gをインタリーブした場合を示したが、2個より多くのS S F B Gをインタリーブすることによってより高密度なくし型特性を有するI S S F B Gを作製することができる。

【0049】

また、上記実施の形態では位相マスク法を用いて本発明に係るI S S F B Gの各サブF B Gを作製する場合について説明したが、F B Gを作製する他の方法を用いて本発明に係るI S S F B Gを作製してもよい。

【0050】

また、上記実施の形態ではI S S F B Gの各S S F B GのサブF B Gを均一グレーティングピッチのグレーティングとしたが、各S S F B GのサブF B Gは、アポダイズグレーティング又はチャープグレーティングであってもよい。尚、アポダイズグレーティングとは周知のようにファイバのコアの長手方向に対して屈折率変化量を変化させたグレーティングであり、チャープグレーティングとは周知のようにファイバのコアの長手方向に対して屈折率変化の周期を変化させたグレーティングである。

【0051】

ここで、各S S F B GのサブF B Gをアポダイズグレーティング又はチャープグレーティングとする場合に、各S S F B Gのアポダイズグレーティング又はチャープグレーティングの反射特性は、全て実質的に同一（反射帯域及び反射率が同一）であってもよいし、また、反射帯域が実質的に同一で反射率が異なる場合であってもよい。

【0052】

また、上記実施の形態では、光ファイバに高密度なくし型特性を有するくし型フィルタを作製する場合について説明したが、上記I S S F B Gと同様に光ファイバ以外のメディア、例えば平面型の光導波路（一次元光導波路）に複数の超格子構造グレーティングをインタリーブにより形成して高密度なくし型フィルタを作製することもできる。

【図面の簡単な説明】

【0053】

【図1】ファイバグレーティングの構造を示した図。

【図2】ファイバグレーティングが形成されるファイバのコアを示した図。

【図3】ファイバグレーティングの屈折率変化の説明に使用した図。

【図4】ファイバグレーティングの反射特性の説明に使用した図。

【図5】位相マスクを上から見た図。

【図6】位相マスク法の原理の説明に使用した図。

【図7】チルト法によるF B Gの作製の説明に使用した図。

【図8】超格子構造ファイバグレーティングの構造を示した図。

【図9】超格子構造ファイバグレーティングの反射特性を示した図。

【図10】超格子構造ファイバグレーティングにおいてサブF B G間隔を変更した場合の反射特性を示した図。

【図11】インタリーブ法の説明に使用した図。

【図12】本実施の形態のインタリーブ超格子構造ファイバグレーティングの説明に使用した図。

【図13】位相の説明に使用した図。

【図14】本実施の形態のインタリーブ超格子構造ファイバグレーティングを用いたくし型フィルタ装置の一例を示した構成図。

【図15】本実施の形態のインタリーブ超格子構造ファイバグレーティングを位相マスクを使用して作製する場合の一例を示した図。

【図16】本実施の形態のインタリーブ超格子構造ファイバグレーティングを位相マスクを使用して作製する場合の一例を示した図。

【符号の説明】

【0054】

10 ... ファイバグレーティング (F B G)、12 ... 感光性ファイバ、14 ... コア、22 ...

10

20

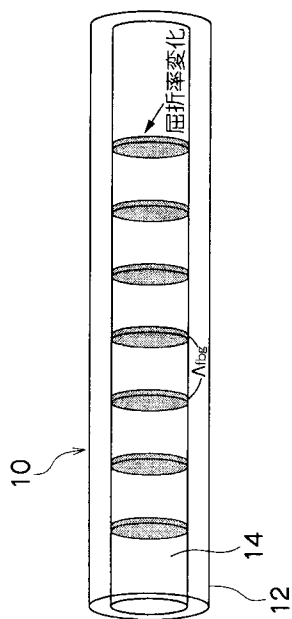
30

40

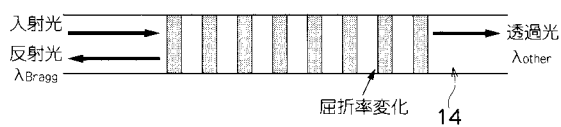
50

回折格子、24...位相マスク、30、32...サブFBG、31、33、35...空隙部、40...ISSFBG、50...くし型フィルタ装置、52...光サーキュレータ、54...光アンプ、56...光源

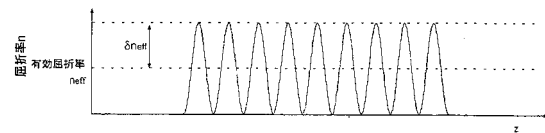
【図1】



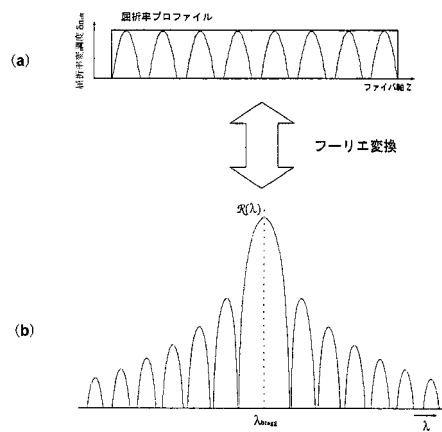
【図2】



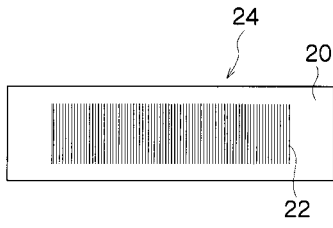
【図3】



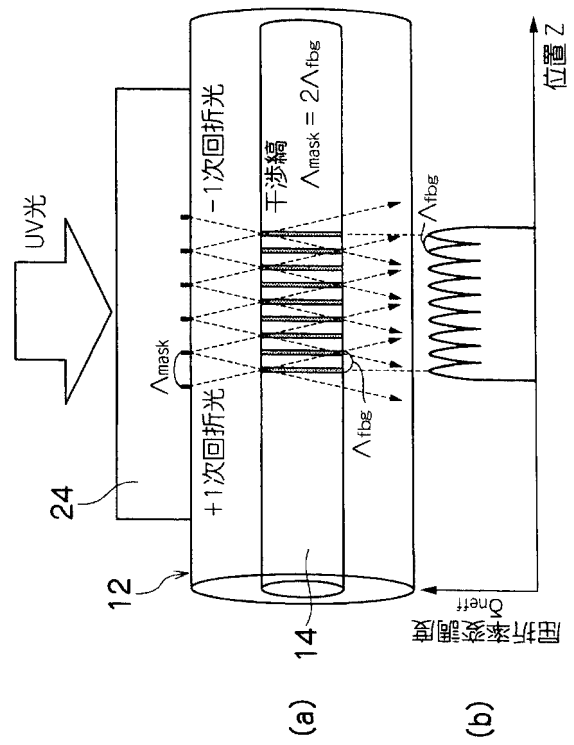
【図4】



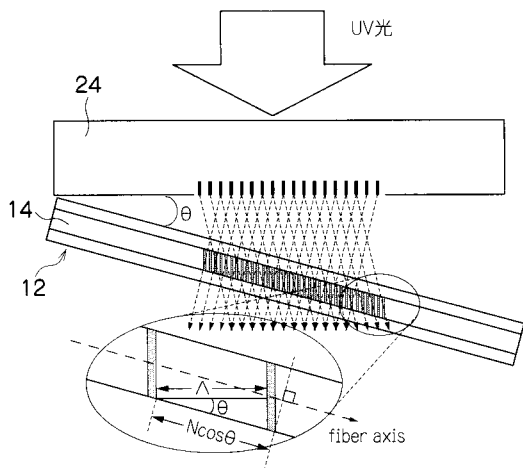
【 図 5 】



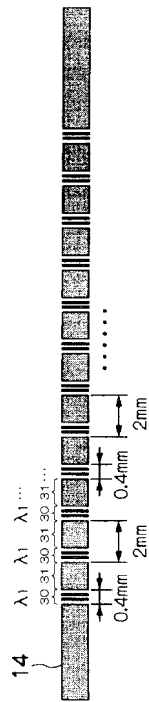
【 図 6 】



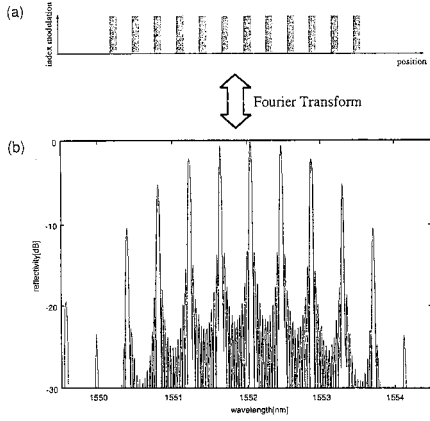
【 図 7 】



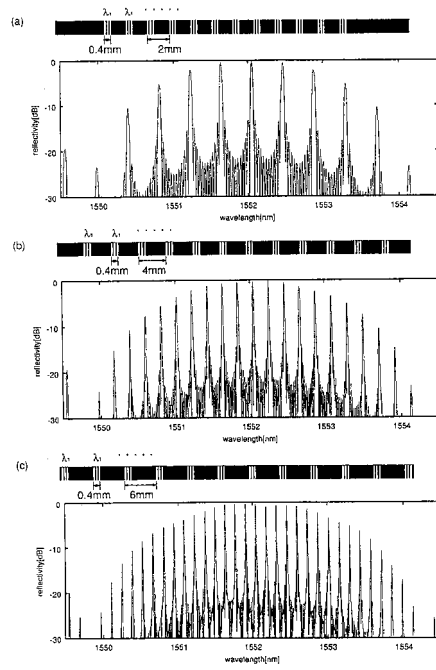
【 図 8 】



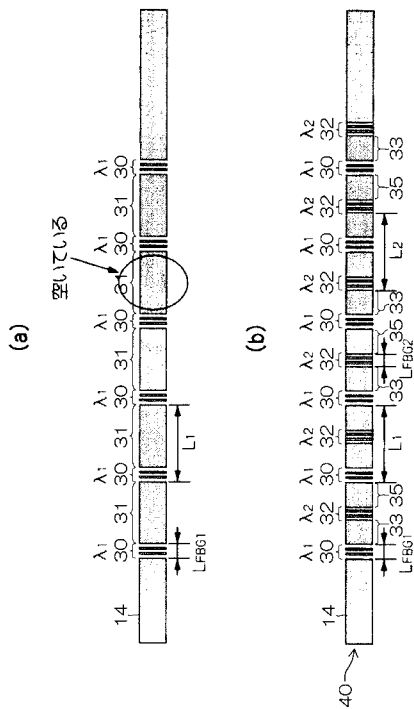
【 図 9 】



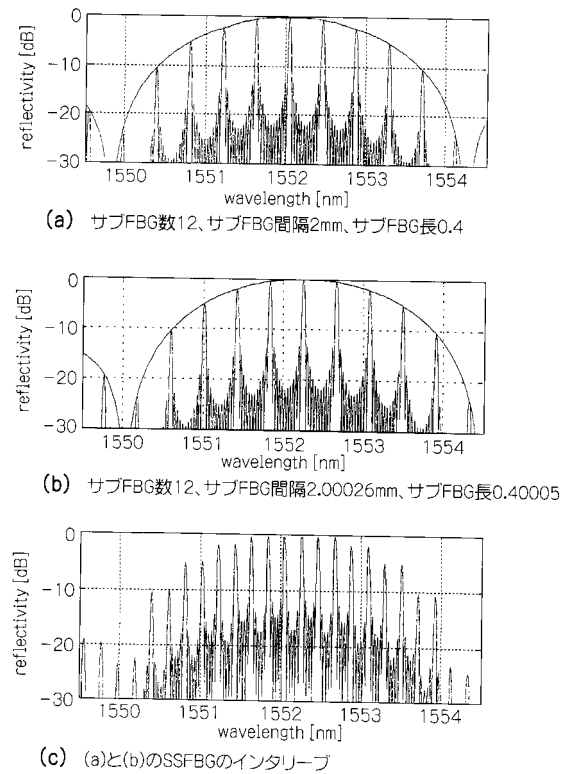
【 図 10 】



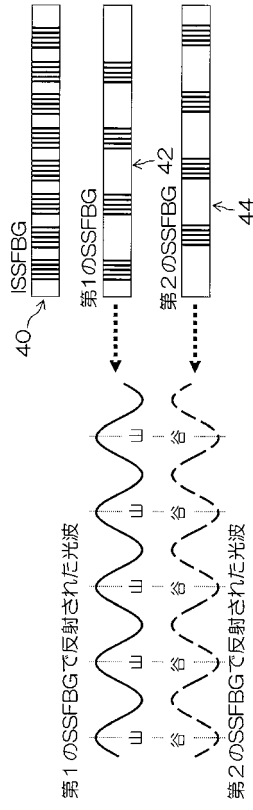
【 図 11 】



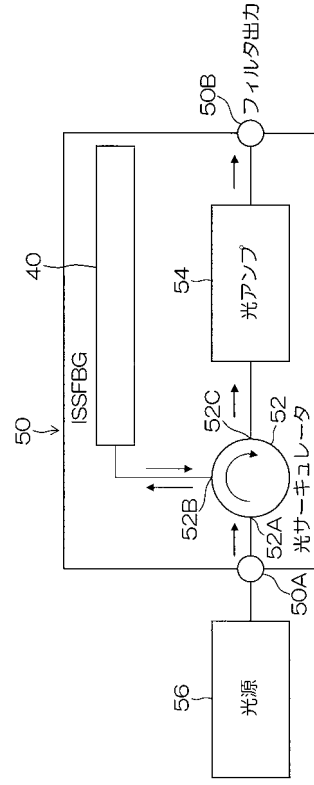
【 図 12 】



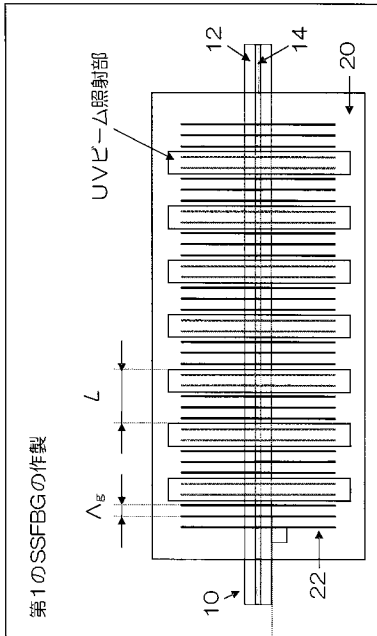
【図13】



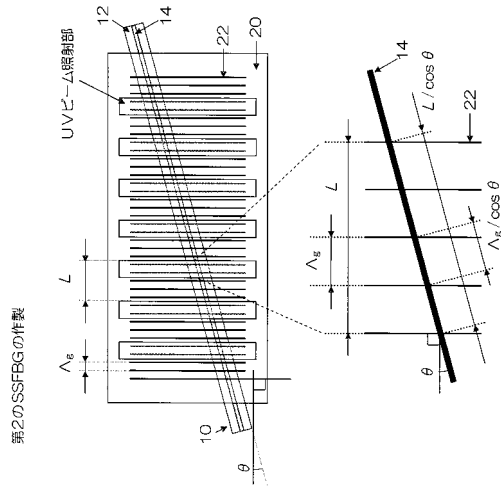
【図14】



【図15】



【図16】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開平 1 1 - 0 1 4 8 5 8 (J P , A)

特開平 1 1 - 5 0 0 5 3 9 (J P , A)

特開 2 0 0 0 - 2 7 5 4 4 2 (J P , A)

特開 2 0 0 3 - 0 0 4 9 2 6 (J P , A)

特開 2 0 0 4 - 1 6 3 5 4 3 (J P , A)

特開 2 0 0 4 - 2 4 0 3 2 4 (J P , A)

特表 2 0 0 2 - 5 1 9 7 1 2 (J P , A)

R. Kashyap et al. , Super-step-chirped fibre Bragg gratings , ELECTRONICS LETTERS , 1 9
9 6 年 7 月 1 8 日 , Vol. 32, No. 15 , P. 1394-1396

W. H. Low et al. , Sampled Fiber Grating Based-Dispersion Slope Compensator , IEEE PHOTO
NICS TECHNOLOGY LETTERS , 1 9 9 9 年 1 0 月 , Vol. 11, No. 10 , P. 1280-1282

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

G 0 2 B 5 / 1 8

G 0 2 B 6 / 0 2